

REFERENCES

- [1] <http://www.eudil.fr/eudil/tec35/hemt/Hemtc1b1.htm>
- [3] <http://www.eudil.fr/eudil/tec35/hemt/biblioc1b2.htm>
- [2] http://fr.wikipedia.org/wiki/Structure_cristalline
- [4] E.M.Conwell. dans « Highfield transport in semiconducteurs » solid state physics supplent 9, p. 149 Acamedic press, (1967).
- [5] <http://www.eudil.fr/eudil/tec35/hemt/Hemtc1b3.htm>
- [6] Conwell, EM., Weisskopf, V.F. :Phys. Rev.77 ,388 (1950).
- [7] Brooks, H., Herring, C. :Phys.Rev.83,879 (1951).
- [8] U.Ravaioli « ECE439 - théorie avancée de simulation de semi-conducteurs. Simulation de Monte Carlo1994». Chapitre3
- [9] Hocine HOUILI «Approches numériques du transport de charges dans les semi-conducteurs organiques » Chapitre 3 : Simulation microscopique : MonteCarlo. Thèse no 3631 (2006)
- [10] T. Kurosawa, journal of the physical society of japan, suplement 21, p. 424(1966).
- [11] H.D.Ress, Journal of physics and Chimistry of solids, Volume30 p.643, (1969).
- [12] W. Fawcett, A.D. Roardman, S. Swain, Journal of physics and Chimistry of solids, Volume 31, p. 1963, (1970).
- [13] J.G. Ruch, W. Fawcett, Journal of applied physics, Volume 41, p.3843, (1970).

- [14] P.J. Price IBM Journal of Research and developpement, Volume 17, p. 39, (1973).
- [15] A.D. Boardman, W. Fawcett, H. D Ress, Solid State communications, Volume 6, P.305,(1968).
- [16] A. Alberigi Quaranta, c.Jacoboni, G.Ottaviani, Revista del Nuovo Cimento, Volume 1, p.445, (1971).
- [17] Fatima Zohra OTMANI « Etude du transport électronique par la méthode de Monte Carlo. Application : Silicium, Germanium et le composé $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$. » Chapitre 3 : Procédure de choix d'interaction. (2003). Thèse de Magister (2003).
- [18] SAYEH Choukria « application de la méthode de Monte Carlo aux composés III-V ». Thèse de magister en électronique, université Abou Bekr Belkaid (2002).
- [19] Abdelhafid LALLAM « simulation des propriétés électroniques des composés ternaires par la méthode de Monte Carlo ». Thèse de Magister (2005).
- [20] W.A.Harrisson, Physical Review B, Volume 104, p. 1281, (1956). Introduction
- [21] Lecture: Kittel, Chapt 1-3, Ashcroft & Mermin, Chapt 4-7.
- [22] <http://www.unine.ch/phys/Enseignement/Cours20032004/PhysSemi/Cours/Sem/node4.html#SECTION00420>
- [23] Jacoboni, C., Lugli, P: The Monte Carlo Method for Semiconductor Device Simulation, P 46, 47
- [24] Applied physics review « Band parameters for III- V compound semiconductors and their alloys » Volume 89. Number11, 1JUNE 2001